

Сведения о члене экспертной комиссии

1	ФИО (полностью)	Васильевский Иван Сергеевич
2	Дата рождения (полная)	15.06.1980
3	Гражданство	РФ
4	Ученая степень (с указанием шифра специальности научных работников, по которой защищена диссертация)	Д.ф.-м.н. 05.27.01 Твердотельная электроника, радиоэлектронные компоненты, микро- и нанoeлектроника, приборы на квантовых эффектах.
5	Ученое звание (по кафедре, специальности)	доцент
6	Место работы:	
	Почтовый индекс, адрес, web-сайт, электронный адрес организации	Россия, 115409, г. Москва, Каширское шоссе, д. 31 https://mephi.ru/ info@mephi.ru
	Полное наименование организации в соответствии с уставом	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
	Ведомственная принадлежность организации	Министерство образования и науки Российской Федерации
	Тип организации	Автономное учреждение
	Наименование подразделения	Институт нанотехнологий в электронике, спинтронике и фотонике
	Должность	Ведущий научный сотрудник Центр радиофотоники и СВЧ-технологий института нанотехнологий в электронике, спинтронике и фотоники
7	Основные публикации в области диссертационного исследования (для членов, представляющих технические науки: не менее 7 научных статей за последние 5 лет из Перечня ВАК, из которых не менее 2-х в Scopus/WoS; для членов, представляющих физико-математические науки: не менее 8 научных статей за последние 5 лет из Перечня ВАК, из которых не менее 3-х в Scopus/WoS):	
	1. D.V. Ushakov, A.A. Afonenko, A.A. Dubinov, V.I. Gavrilenko, I.S. Vasil'evskii, N.V. Shchavruk, D.S. Ponomarev and R.A. Khabibullin. Mode loss spectra in THz quantum-cascade lasers with gold- and silver-based double metal waveguides.// Quantum Electronics, V. 48, N.11, 1005. doi.org/10.1070/QEL16806 2. Victor Krivenkov, Pavel Samokhvalov, Ivan S. Vasil'evskii, Nikolai I. Kargin and Igor Nabiev. Plasmon–exciton interaction strongly increases the efficiency of a quantum dot-based near-infrared photodetector operating in the two-photon absorption mode under normal conditions.// Nanoscale, 2021. doi.org/10.1039/D1NR06229H 3. D.I. Khusyainova, E.D. Mishinaa, V.A. Khomchenkob, I.S. Vasil'evskii, A.M. Buryakova, M.S. Ivanovab, S.A. Nomoevc. An advanced approach to control the electro-optical properties of LT-GaAs-based terahertz photoconductive antenna.// Materials Research Bulletin, V. 122, 2020, 110688. doi.org/10.1016/j.materresbull.2019.110688 4. D.A. Safonov, A.N. Klochkov, A.N. Vinichenko, Yu D. Sibirmovsky, N.I. Kargin,	

I.S.Vasil'evskii. Electron effective masses, nonparabolicity and scattering times in one side delta-doped PHEMT AlGaAs/InGaAs/GaAs quantum wells at high electron density limit.// Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, V. 133, 2021, 114787. doi.org/10.1016/j.physe.2021.114787

5. D. A. Safonova, A. N. Vinichenko, N. I. Kargin, and I. S. Vasil'evskii. Electron Transport in PHEMT AlGaAs/InGaAs/GaAs Quantum Wells at Different Temperatures: Influence of One-Side δ -Si Doping.// Semiconductors, 2018, Vol. 52, No. 2, pp. 189–194. DOI: 10.1134/S106378261802015X

6. G. B. Galiev, I. N. Trunkin, A. L. Vasiliev, I. S. Vasil'evskii, A. N. Vinichenko, E. A. Klimov, A. N. Klochkov, P. P. Maltsev & S. S. Pushkarev. New Structure for Photoconductive Antennas Based on {LTG-GaAs/GaAs:Si} Superlattice on GaAs(111)A Substrate.// Crystallography Reports, v. 64, p. 205–211, 2019. doi.org/10.1134/S1063774519020111

7. I.V. Altukhov, S.E. Dizhur, M.S. Kagan, N.A. Khvalkovskiy, S.K. Paprotskiy, I.S. Vasil'evskii, A.N. Vinichenko. Anomalous Photoresponse of Heavily Doped GaAs/AlAs Superlattices with Electric Domains.// Condensed Matter, Submitted on 4 Nov 2021. DOI:10.1134/S1064226921440017

8. Alexander Shurakov, Pavel Mikhalev, Denis Mikhailov, Boris Voronov, Ivan Vasil'evskii, Gregory Gol'tsmana. Ti/Au/n-GaAs planar Schottky diode with a moderately Si-doped matching sublayer.// Microelectronic Engineering, V. 195, 2018, P. 26-31. doi.org/10.1016/j.mee.2018.03.008

9. I. S. Vasil'evskii. Effect of thin heterogeneous functional nanolayers on electron transport in InGaAs-based quantum wells with high electron density.// IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 475 012023, 2019. doi.org/10.1088/1757-899X/475/1/012023

10. R. Khabibullin, D. Ushakov, A. Afonenko, N. Shchavruk, D. Ponomarev, O. Volkov, V. Pavlovskiy, I. Vasil'evskii, D. Safonov, A. Dubinov. Silver-based double metal waveguide for terahertz quantum cascade laser.// Proc. SPIE 11022, International Conference on Micro- and Nano-Electronics 2018, 1102204, 2 019. doi.org/10.1117/12.2521774

8	Контактный телефон члена экспертной комиссии (желательно мобильный)
9	Адрес электронной почты